



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz Oferty

Nr sprawy: **PO.2721.16.23**

W nawiązaniu do ogłoszenia na materiały do epitaksji dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, składam/y niniejszą ofertę

1. WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
NIP	
REGON	
KRS	
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

2. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego;
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania ofertowego;
- 3) cena mojej oferty za prawidłową i pełną realizację zamówienia wynosi:

a) *Cena wynosi zł netto,*

słownie:

b) *Cena wynosi zł brutto,*

słownie:

Powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty materiałów i inne.



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/L-PORT/Ct/2021





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Oświadczam, że termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi
(słownie:.....) dni roboczych

- 4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni;
- 5) oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu;
- 6) oświadczam, że posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- 7) oświadczam, że posiadam zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 8) oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

3. Podpis(y):

Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data



Strona 2 z 2



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/t-PORT/Ct/2021

